NANOPHYSIQUE INTRODUCTION PHYSIQUE AUX NANOSCIENCES

3. AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

James Lutsko

2023-2024

AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

• L'auto-assemblage: Nucleation

- Modele de l'amas: "capillary model".
- Thermodynamics
- Becker-Doring model
- Zeldovich equation
- Taux de nucléation
- Nanoparticules cristalline
 - Structure cristalline
 - Indices de Miller
 - Tension de surface
 - Forme des Cristaux
 - Transistions de phase
- Proprietes electronique des agregats

A simple but realistic example: Liquid-vapor transition







L'energie libre (ensemble généralisé)

 $\Omega = V(R)\omega_1 + S(R)\gamma_{12} + (V - V(R))\omega_2$

 ω est l'energie volumique par unite de volume, γ est l'energie surface

Minimisez par rapport à R:

$$0 = \frac{\partial \Omega}{\partial R} \rightarrow S(R) \omega_1 + S'(R) \gamma_{12} = S(R) \omega_2$$



Si $\omega_i = \omega(\rho_i)$ on droit minimiser par rapport aux densities:

 $0 = \frac{\partial \Omega}{\partial \rho_i} \rightarrow \frac{\partial \omega(\rho_i)}{\partial \rho_i} = 0$ Rappelez-vous que $\omega(\rho) = f(\rho) - \mu \rho \rightarrow \omega'(\rho) = f'(\rho) - \mu$

Donc,

$$f'(\rho_i) = \mu \rightarrow \omega(\rho_i) = f(\rho_i) - f'(\rho_i)\rho_i = -P(\rho_i)$$

$$0 = \frac{\partial \Omega}{\partial R} \rightarrow -P(\rho_1) + \frac{S'(R)}{S(R)} \gamma_{12} = -P(\rho_2)$$

Equation de Laplace:

$$P_{\rm int} = P_{\rm ext} + \frac{2\gamma_{12}}{R}$$

L'energie libre (ensemble canonique)

 $F = V(R) f_1 + S(R) \gamma_{12} + (V - V(R)) f_2$

f est l'energie volumique par unite de volume, est c'est N qui est constante: $\rho_1 V(R) + \rho_2 (V - V(R)) = N$

Minimiser par rapport à R (assume ρ_1 constant)

$$0 = \frac{\partial F}{\partial R} = S(R)f_1 + S'(R)\gamma_{12} - S(R)f_2 + (V - V(R))f'_2 \frac{\partial \rho_2}{\partial R}$$



$$S(R)(f_1 - f'_2 \rho_1) + S'(R)\gamma_{12} = S(R)(f_2 - f'_2 \rho_2)$$

Minimize par rapport à la premiere densitie: $0 = V(R) f'_{1} + (V - V(R)) f'_{2} \frac{\partial \rho_{2}}{\partial \rho_{1}} = V(R) (f'_{1} - f'_{2})$

Puis, c'est la même qu'avant sauf

$$\rho_{2} = \frac{N - \rho_{1} V(R)}{(V - V(R))} = \frac{N}{V} + \left(\frac{N}{V} - \rho_{1}\right) \frac{V(R)}{V} + \dots$$

Donc, la deux calcul (dans l'ensemble canonique est dans l'ensemble généralisé) sont équivalent dans la limit $V \rightarrow \infty$

En fait et en general, les ensembles sont equivalent dans ce cas.

Équivalence d'ensemble (d'apres Oxtoby et Evans, J. Chem. Phys. 89, 7521 (1988)):

$$\Omega = -PV + \gamma S \qquad F = -PV + \gamma S + \mu N = \Omega + \mu N$$

Donc, pour la difference:

$$\Omega_{1} - \Omega_{2} = -(P_{1} - P_{2}) + \gamma S$$

$$F_{1} - F_{2} = -(P_{1} - P_{2})V + \gamma S + (\mu_{1} - \mu_{2})N$$

 $\Delta \Omega = \Delta F \Leftrightarrow \mu_1 = \mu_2 \Leftrightarrow$ thermodynamic limit

Par ailleurs, un methode plus simple dans l'ensemble canonique:

 $dF = -SdT - PdV + \gamma dA$ $dF = -SdT - P_{int} dV_{int} - P_{ext} dV_{ext} + \gamma dA$



$$V_{\text{int}} = \frac{4\pi}{3} R^3 \qquad dV_{\text{int}} = 4\pi R^2 dR$$

$$V_{\text{ext}} = V - V_{\text{int}} \qquad dV_{\text{ext}} = -dV_{\text{int}} \qquad A = 4\pi R^2 \qquad dA = 8\pi R dR$$

 $0 = dF = (-P_{int} + P_{ext}) 4 \pi R^2 dR + \gamma 8 \pi R$

Equation de Laplace:

$$P_{\rm int} = P_{\rm ext} + \frac{2\gamma}{R}$$

Energie libre

Energie libre de Helmholtz (ensemble canonique):

 $F(\rho; T, V) = f(\rho; T)V$

Gaz parfait:

$$\beta f(\rho;T) \equiv \beta f_{id}(\rho;T) = \rho \ln \rho - \rho$$

Gaz hard-sphere avec diametre d (Carnahan-Starling approximation):

$$\beta f_{hs}(\rho;T) = \beta f_{id}(\rho;T) + \rho \eta \frac{4-3\eta}{(1-2\eta)^2}, \quad \eta = \frac{4\pi}{3} (d/2)^3 \rho = \frac{\pi}{6} \rho d^3$$

Champ moyenne (van der Waals):

$$\beta f(\rho;T) = \beta f_{hs}(\rho;T) - \frac{1}{2}a\rho^2 \qquad a = \beta \int v_{att}(r) dr$$

Les transitions de phase



Coexistence de deux phase: $p_1 = p_2$, $f_1 = f_2$



DOI: 10.1126/science.335.6064.11-f

Crystallization is a hot topic ...





Les transitions de phase : le processus





$$\Omega = V(R)\omega_2 + S(R)\gamma + (V - V(R))\omega_1$$

= V(R) \Delta \omega + S(R)\gamma + V\omega_1
\Delta \Omega = V(R) \Delta \omega + S(R)\gamma



Monomer attachment/detachment (Becker-Doring c. 1930):

$$\frac{dc_n}{dt} = (f_{n-1}c_{n-1}c_1 - g_nc_n) - (f_nc_nc_1 - g_{n+1}c_{n+1})$$

 f_n, g_n sont les taux de fixation et de détachement des monomères

Monomer attachment/detachment (Becker-Doring c. 1930):

$$\frac{dc_n}{dt} = (f_{n-1}c_{n-1}c_1 - g_nc_n) - (f_nc_nc_1 - g_{n+1}c_{n+1})$$

Si l'on developper pour $n \gg 1, c_n(t) \rightarrow c(n, t)$ etc.

$$f(n-1)=f(n)-f'(n)+\frac{1}{2}f''(n)+...$$

on se trouve

$$\frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(\left(g(n) - f(n) \right) c(n,t) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial n} \left(f(n) + g(n) \right) c(n,t) + \dots \right)$$

"Tunitskii equation"

Monomer attachment/detachment (Becker-D'oring c. 1930): Si l'on demande aussi la condition de bilan détaillé ("detailed balance"),

$$f(n)e^{-\beta\Delta\Omega(n)}=g(n+1)e^{-\beta\Delta\Omega(n+1)}$$

est developpe comme

$$g(n) = f(n-1)e^{\beta \Delta \Omega(n) - \beta \Delta \Omega(n-1)}$$

= $f(n) - \frac{\partial f(n)}{\partial n} + f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega(n)}{\partial n} + \dots$

on trouve une resultat trés connu, l'equation de Zeldovich (1942):

$$\frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(-f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} + f(n) \frac{\partial}{\partial n} \right) c(n,t)$$

Notez qu'il semble un équation de type Fokker-Planck.

Classical Nucleation Theory (CNT) : Nucleation rates

Si l'on commence avec une solution de monomères, éventuellement un cristal sera nucléée et il va consommer les monomères. C'est une

processus pas soutenu. Mais, si l'on ajouter des monomères est si l'on enleve des amas post-critique, on peut faire une état stationairre. Dans ce cas, la solution de l'equation Zeldovich est facile:

$$0 = \frac{dc(n,t)}{dt} = \frac{\partial}{\partial n} \left(-f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} + f(n) \frac{\partial}{\partial n} \right) c(n,t)$$
$$J = -f(n) \frac{\partial \beta \Delta \Omega}{\partial n} c(n,t) + f(n) \frac{\partial}{\partial n} c(n,t)$$
$$= -f(n) e^{-\beta \Delta \Omega} \frac{\partial}{\partial n} e^{\beta \Delta \Omega} c(n,t)$$

$$c(n) = A e^{-\beta \Delta \Omega(n)} + B e^{-\beta \Delta \Omega} \int_{1}^{n} e^{\beta \Delta \Omega(n')} / f(n') dn'$$

Alors, car c (n^{*}) = 0, la solution est $C(n) = Be^{-\beta\Delta\Omega} \int_{n}^{n^{*}} e^{\beta\Delta\Omega(n')} / f(n') dn'$

Classical Nucleation Theory (CNT) : Nucleation rates

On peut écrire le résultat comme

$$c(n) = c(1)e^{-\beta(\Omega(n) - \Omega(1))} \int_{n}^{n^{*}} e^{\beta \Delta \Omega(n')} / f(n') dn' / \int_{1}^{n^{*}} e^{\beta \Delta \Omega(n')} / f(n') dn'$$

La taux est simplement la flux:

$$J = -f(n)e^{-\beta\Delta\Omega}\frac{\partial}{\partial n}e^{\beta\Delta\Omega}c(n,t)$$
$$= c(1)\left(\int_{1}^{n^{*}}e^{\beta\Delta\Omega(n)}/f(n)dn\right)^{-1}$$

Un évaluation par "steepest descent" donne le resultat

$$J \approx c_1 f(n_c) \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \sqrt{|\Delta\beta\Omega''(n_c)|} \exp(-\Delta\beta\Omega(n_c))$$

Monomer attachment frequency: Diffusion-limited growth

La taux de fixation de monomères est évidemment determiné par la taux auquel les monomères frappe la surface Pour ca, on suppose que le mouvement des momomères est par la processus de diffusion. Donc,

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = D \nabla^2 c_1 = D \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r c_1$$

On suppose que il y a un état de quasi-equilibre,

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = 0 = D \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} r c_1 \rightarrow c_1(r) = c_1(\infty) + \frac{a}{r}$$

Si chaque molécule qui arrive est fixé, la condition à la limite est c(R) = 0 de sorte que

$$c_1(r) = c_1(\infty)(1 - \frac{R}{r})$$

Monomer attachment frequency: Diffusion-limited growth

Parce-que on a une état stationnaire, la nombre total des monomères dans la volume total est constant:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} c_{1}(r;t) d\mathbf{r} = D \int_{V} \nabla^{2} c_{1} d\mathbf{r}$$
$$= D \left(S(R_{max}) c'_{1}(R_{max}) - S(R) c'_{1}(R) \right)$$

Donc, la nombre fixé sur la surface par unité de temps est simplement DS(R)c'(R) de sorte que

$$f_{n} = f(R(n)) \qquad c_{1}(r) = c_{1}(\infty)(1 - \frac{R}{r})$$

= $D4\pi R^{2}(n)c'(R)$
= $D4\pi R(n)c_{1}(\infty) \qquad c'_{1}(r) = c_{1}(\infty)\frac{R}{r^{2}}$

AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

- L'auto-assemblage: Nucleation
 - Modele de l'amas: "capillary model".
 - Thermodynamics
 - Becker-Doring model
 - Zeldovich equation
 - Taux de nucléation

• Nanoparticules cristalline

- Structure cristalline
- Indices de Miller
- Tension de surface
- Forme des Cristaux
- Transistions de phase
- Proprietes electronique des agregats

NANOPARTICULES CRISTALLINES



Co nanoparticle

M. Jamet et al., Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 4676



CoPt₃ nanoparticle

Shevchenko, O'Brien, Murray (Columbia, IBM)

Structure des cristaux

Structure: Réseau Bravais avec une ou plusieurs molécules positionné par rapport au point du réseau.

Les point du réseau sont donnés comme:

 $\mathbf{R}_{i} = n_{1} \mathbf{a}_{1} + n_{2} \mathbf{a}_{2} + n_{3} \mathbf{a}_{3}$

ou $\{a_i\}$ sont les vecteur de bases du réseau est $\{n_i\}$ sont des nombres entiers.



http://en.wikipedia.org/wiki/Face-centered_cubic

Structure des cristaux (suite)

Réseau réciproque :tous les vecteurs d'onde qui sont périodique sur le réseau :

$$\exp(i\boldsymbol{K}_{j}\cdot(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}_{l})) = \exp(i\boldsymbol{K}_{j}\cdot\boldsymbol{r}) \rightarrow \boldsymbol{K}_{j}\cdot\boldsymbol{R}_{l} = 2\pi n\delta_{jl}, \qquad n \in \mathbb{Z}$$

Il s'ensuite que $\mathbf{K} = \sum_{j=1}^{d} m_j \mathbf{b}_j$

ou
$$\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{b}_j = 2 \pi \delta_{ij} \rightarrow \boldsymbol{b}_1 = 2 \pi \frac{\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3}{\boldsymbol{a}_1 \cdot (\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3)}$$

Théorème: pour chaque famille de plans du réseau séparés par une distance "d", il ya des vecteurs du réseau réciproque perpindicular les plans et la plus courte a une longueur de $2\pi/d$.

(Apres Mermin and Ashcroft, "Solid State Physics", Holt, Reinhard and Winston, 1976, PA.)

Preuve:

Si la normale aux plans est \hat{n} , la vecteur $K = 2\pi \hat{n}/d$ est dans la réseau réciproque:

Parce-que si $\mathbf{R}_i \in \text{plane } m_i$ et $\mathbf{R}_i \in \text{plane } m_i$

$$\begin{aligned} \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{i} &= \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{j} + \mathbf{K} \cdot \left(\mathbf{R}_{i} - \mathbf{R}_{j}\right) \\ &= \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{j} + \mathbf{K} \cdot \left\{\left(m_{i} - m_{j}\right) d \, \mathbf{\hat{n}} + \left(\mathbf{R}_{i} - \mathbf{R}_{j}\right)_{\text{perp}}\right\} \\ &= \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{j} + 2 \, \pi \left(m_{i} - m_{j}\right) \\ &= 2 \, \pi \left(m_{i} - m_{0}\right) \text{ parceque } \mathbf{R}_{0} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

 $\rightarrow \exp\left(i\,\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{R}_{i}\right) = \exp\left(i\,2\,\pi\left(m_{i}-m_{0}\right)\right) = 1$

Les indices de Miller d'un plan du réseau sont les coordonnées du plus petit vecteur du réseau réciproque qui soit normal à ce plan, par rapport à un ensemble spécifié de vecteurs de bases. Un plan d'indices de Miller (h,k,l) est donc normal au vecteur du réseau réciproque:

 $K = h b_1 + k b_2 + l b_3$, (h, k, l)des entiers sans facteur commun $\boldsymbol{b}_i \cdot \boldsymbol{a}_i = 2\pi \delta_{ii}$ **Alternative:** Eq. pour plane $K \cdot r = A$ (001) (100) (010) $\mathbf{r} = x_1 \mathbf{a}_1 \rightarrow A = \mathbf{K} \cdot \mathbf{r} = x_1 \mathbf{K} \cdot \mathbf{a}_1 = 2 \pi x_1 h$ donc, $h = A/x_1$, ... $k = A/x_2$... $l = A/x_3$ (101) (110)(011) $\rightarrow h:k:l=\frac{1}{x_1}:\frac{1}{x_2}:\frac{1}{x_3}$ (111) (111) (111)

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Miller_Indices_Cubes.svg&page=1



cristal cubique faces centrées



cristal cubique faces centrées



Surfaces: Propriétés

Souvent, la propriété la plus importante de surfaces différentes sont leurs densités.

Volume du cellule unitaire: $V = |\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)|$

Densité des pointes sur un plan de réseau: $\sigma = d/v$

Les plus denses plans:

FCC: (111) BCC: (110) SC : (100)

TENSION DE SURFACE: ANISOTROPIE



Energie d'un atome de terrace: *a* Energie d'un atome de marche: *b*

Energie par unité de surface:

 $\gamma = \frac{an+b}{\sqrt{n^2+1}} \qquad \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \cos \theta$ $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \sin \theta$

Angle entre le plan de surface et les terraces: θ

Tension superficielle: $\gamma(\theta) = a \cos \theta + b |\sin \theta|$

TENSION DE SURFACE: ANISOTROPIE





H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

FORME DES CRISTAUX

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface (Curie, 1885; Wulff, 1901).

Energie libre: $dF = -P_F dV_F - P_C dV_C + regression \gamma dA$ F = phase fluide

C = cristal

conservation du volume:

$$dV_{\rm F} = -dV_{\rm C}$$

$$dF = -(P_{\rm C} - P_{\rm F})dV_{\rm C} + r r dA = 0$$

Energie de surface minimum:

contrainte de volume constant:

 $\int dV = \int Cst$

 $\min \varphi(\mathbf{n}) dA$

FORME DES CRISTAUX (suite)

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface (Curie, 1885; Wulff, 1901).

Décomposition du cristal en domaines pyramidaux:



Parce-que la pyramid est autosimilaire ("self-similar") comme fonction de la distance au-dessous la point, la surface d'une section varie comme $A(h) = A(h_0) \times (\frac{h}{h_0})^2$ indépendamment de la forme. Donc, la volume est $\int_{0}^{h_n} A(z) dz = \frac{1}{3} A_n h_n$

FORME DES CRISTAUX (suite)

La forme d'un cristal est celle qui minimise l'énergie de surface (Curie, 1885; Wulff, 1901).

Il s'ensuite que

$$A_n(h) = A_n(h_0) h_n^2 \rightarrow \delta A_n = 2(A_n/h_n) \delta h_n$$
$$V_n = \frac{1}{3} A_n h_n \rightarrow \delta V_n = A_n \delta h_n$$

Minimisez l'énergie de la surface à volume constante:

$$\delta(F - \lambda(V - V_0)) = \delta \Delta P V + \delta \sum A_n \gamma_n - \lambda \delta V - \delta \lambda(V - V_0)$$

$$0 = \sum \left(\frac{2}{h_n} A_n \gamma_n - \lambda A_n + \Delta P A_n\right) \delta h_n + \delta \lambda (V - V_0)$$

$$0 = \sum \left(\gamma_n - \frac{(\lambda - \Delta P)}{2} h_n \right) 2 A_n \frac{\delta h_n}{h_n} + \delta \lambda (V - V_0)$$

$$\Rightarrow h_n = constant \times \gamma_n$$

CONSTRUCTION DE WULFF (1901)



U. Diebold, The surface science of titanium dioxide, Surf. Sci. Rep. 48 (2003) 53-229

STRUCTURES D'EQUILIBRE 3D

T = 0: polyhèdre avec faces planes et arêtes anguleuses

 $0 < T < T_{\rm R}$: faces planes avec arêtes arrondies

- $T_{\rm R} < T$: surface arrondie
- $T_{\rm R}$: température de la transition rugueuse

- (a) cristal de Pb vu dans la direction [110], T = 300 K
- (b) Pb/Ru(001), T = 323 K, rayon des faces ~ 140 nm
- (c) cristal de Pb, T = 363 K, rayon de la face (111) ~ 230 nm



H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

STRUCTURES D'EQUILIBRE 3D



(111)1000-(100) Z_0 (111)Z(x) 500 Au crystallite on SiC annealed at 1123 K -1500 -1000 -500 500 1000 1500 0 (b) х

Image SEM d'un cristal de Au sur un substrat de SiC, incubation pendant 72h à T = 1123 K

Cristal d'un alliage de Ni avec 5% Pb et 0,08% Bi, à T = 548 K



H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

STRUCTURES D'EQUILIBRE 2D

tension de ligne (tension de surface à 1D)

T = 0: polygone T > 0: îlot arrondi

La température de la transition rugueuse est nulle à 2D, car il n'y a pas de transition de phase à 1D.

Ilots sur une surface de Pb(111): (a) T = 150 K, 250 nm x 250 nm (b) T = 167 K, rayon de la face du dessus ~ 36 nm (c) T = 172 K, rayon ~ 32 nm (d) T = 277 K, rayon ~ 42 nm (e) T = 308 K, rayon ~ 280 nm (f) T = 323 K, rayon ~ 110 nm



H. P. Bonzel, 3D equilibrium crystal shapes in the new light of STM and AFM, Phys. Rep. 385 (2003) 1-67

Il n'y a pas de transition de phase à 1D.

Théorème: Il n'ya pas de transition de phase dans un système 1D infinie si les interactions sont à courte portée. (Landau, 1950)



 $\Delta F = F_I - F_{II} = -4\epsilon + k_B T \ln N > 0$ si *N* est assez grande.

Il n'y a pas de transition de phase à 1D.

Théorème: Il n'ya pas de transition de phase dans un système 1D infinie si les interactions sont à courte portée.

Preuve (Landau, 1950)

L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Statistical Physics I (Pergamon Press, New York,(1980).

S'il ya deux phases et une transition entre les deux, alors il ya une condition de coxistence. À la coexistence, le modèle capillaire donne

$$\Omega = L \omega + n\gamma + k_B T \left(\frac{n}{L} \ln \left(\frac{n}{L} \Lambda \right) - \frac{n}{L} \right) L$$
$$= L \omega + n\gamma + k_B T \left(n \ln (n) - n \left(1 - \ln \left(\frac{\Lambda}{L} \right) \right) \right)$$

Ce qui est nouveau, le dernier terme, est l'entropie d'une solution diluée des frontières (simplement, l'energie d'un gaz parfait). Mais,

$$\frac{\partial \Omega}{\partial n} = \gamma + k_B T \ln(n) + k_B T \ln\left(\frac{\Lambda}{L}\right) < 0, \quad \text{si } \frac{\Lambda}{L} \Rightarrow 0$$

La bord de "courte porteé" est l'inverse du carré. D. Ruelle, Comm. Math. Phys. 9:267 (1968), F. J. Dyson, Comm. Math. Phys. 12:91 (1969).

Estimates

$$E_{i} = \epsilon N_{i} \Rightarrow \frac{E_{bulk}}{N_{bulk}} = N_{nn} \epsilon$$

$$\gamma = (E_{bulk} - E_{surface}) / A_{surface} = \frac{N_{surface}}{A_{surface}} \times \frac{(E_{bulk} - E_{surface})}{N_{surface}} = \frac{N_{surface}}{A_{surface}} \times \frac{(N_{nn} - N_{surface})}{N_{surface}} \epsilon$$



	SC	FCC
NN	6	12
NN(100)	5	8
NN(110)	4	7
NN(111)	3	9

 \sim



http://en.wikipedia.org/wiki/Face-centered_cubic

EFFET DE TAILLE SUR L'ENERGIE DE LIAISON



(2) structure cristalline (construction de Wulff)

A. Perez, P. Mélinon, J. Lermé et J.-F. Brevet, *Agrégats et colloïdes*, dans: M. Lahmani, C. Dupas et P. Houdy, éditeurs, *Les nanosciences: Nanotechnologie et nanophysique* (Belin, Paris, 2004) pp. 170-254.

EFFET DE TAILLE SUR LA TEMPERATURE DE FUSION

Modele capillaire: $\begin{aligned} \Omega_l = V(R_l)\omega_l + S(R_l)\gamma_l + (V - V(R_l))\omega_v \\ \Omega_s = V(R_s)\omega_s + S(R_s)\gamma_s + (V - V(R_s))\omega_v \end{aligned}$

Donc, on voit que $\begin{array}{c} 0 = \Omega_s - \Omega_l \\ 0 = (V(R_s)\omega_s - V(R_l)\omega_l) + S(R_s)\gamma_s - S(R_l)\gamma_l + (V(R_l) - V(R_s))\omega_v \end{array}$

Developpe a la "triple point", T_0 , μ_0 :

$$0 = (V(R_{s}) - V(R_{l}))\omega_{0} + (\frac{\partial \omega_{s}}{\partial T_{0}}V(R_{s}) - \frac{\partial \omega_{l}}{\partial T_{0}}V(R_{l}))(T - T_{0})$$

$$+ (\frac{\partial \omega_{s}}{\partial \mu_{0}}V(R_{s}) - \frac{\partial \omega_{l}}{\partial \mu_{0}}V(R_{l}))(\mu - \mu_{0}) + S(R_{s})\gamma_{s} - S(R_{l})\gamma_{l} + (V(R_{l}) - V(R_{s}))\omega_{0}$$

$$+ (\frac{\partial \omega_{v}}{\partial \mu_{0}}(\mu - \mu_{0}) + \frac{\partial \omega_{v}}{\partial T_{0}}(T - T_{0}))(V(R_{l}) - V(R_{s}))$$
Utilisant
$$d\Omega = -SdT - PdV - N d\mu$$

$$T_{0}\Delta S = LmN$$
faible
$$0 = LmN \frac{T - T_{0}}{T_{0}} + 3N(\frac{\gamma_{s}}{R_{s}\rho_{s}} - \frac{\gamma_{l}}{R_{l}\rho_{l}}) + (-(\mu - \mu_{0})\rho_{g} + \frac{\omega_{g0}}{T_{0}}(T - T_{0}))(V(R_{s}) - V(R_{l}))$$

$$T = T_{0}(1 - a/R_{s}), \qquad a = \frac{3}{Lm\rho_{s}}(\gamma_{s} - \gamma_{l}(\frac{\rho_{s}}{\rho_{l}})^{2/3})$$

EFFET DE TAILLE SUR LA TEMPERATURE DE FUSION (1)

Température de fusion d'agrégats d'or de diamètre $D = 2R_s$



P. Buffat and J.-P. Borel, Size effect on the melting temperature of gold particles, Phys. Rev. A 13 (1976) 2287.

SOURCE D'AGREGATS



W. A. de Heer, *The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models*, Rev. Mod. Phys. **65** (1993) 611.

TRANSITION DE PHASE D'AGREGATS DE Na



H. Haberland et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 035701

q = latent heat of fusion/atom Δs = entropy change upon melting/atom

M. Schmidt et al., Phys. Rev. Lett. **90** (2003) 103401



AMAS OU AGREGATS ATOMIQUES

- L'auto-assemblage: Nucleation
 - Modele de l'amas: "capillary model".
 - Thermodynamics
 - Becker-Doring model
 - Zeldovich equation
 - Taux de nucléation

• Nanoparticules cristalline

- Structure cristalline
- Indices de Miller
- Tension de surface
- Forme des Cristaux
- Transistions de phase

• Proprietes electronique des agregats

PROPRIETES ELECTRONIQUES DANS LES AGREGATS METALLIQUES

Effets de taille sur le potentiel d'ionisation Effets de tailles sur les propriétés catalytiques

Effets de couches et de supercouches

EFFET DE TAILLE SUR LE POTENTIEL D'IONISATION

Énergie potentielle électrostatique d'une charge q à une distance r du centre d'une sphère conductrice de rayon R:

$$U(r) = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q^2 R^3}{8\pi\varepsilon_0 r^2 (r^2 - R^2)}$$

J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics* (Wiley, New York, 1975).

Différence d'énergie:
$$\Delta U = \lim_{\delta \to R} \left(U(R + \delta R) - U(\infty) \right) = -\frac{3q^2}{32 \pi \varepsilon_0 R}$$

d'ionisation:
$$PI(R) = \Phi + \frac{3q^2}{32\pi\varepsilon_0 R} = \Phi + \frac{5.4 \text{ eV}}{R}$$

Potentiel

travail de sortie du métal: Φ

D. M. Wood, *Classical size dependence of the work function of small metallic spheres*, Phys. Rev. Lett. **46** (1981) 749.

EFFET DE TAILLE SUR LE POTENTIEL D'IONISATION

(a)

W. A. de Heer, *The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models*, Rev. Mod. Phys. **65** (1993) 611.



A. Perez, P. Mélinon, J. Lermé et J.-F. Brevet, *Agrégats et colloïdes*, dans: M. Lahmani, C. Dupas et P. Houdy, éditeurs, *Les nanosciences: Nanotechnologie et nanophysique* (Belin, Paris, 2004) pp. 170-254.

EFFET DE TAILLE SUR LES PROPRIETES CATALYTIQUES

Energie de désorption du CO de particules de Pd sur un support de MgO(100). Taux d'oxydation du CO sur des particules de Pd sur différents supports.



C. R. Henry, Surface studies of supported model catalysis, Surface Science Reports 31 (1998) 231-325.

COUCHES ET SUPERCOUCHES FERMIONIQUES

Elles sont omniprésentes dans les systèmes fermioniques finis:

- atomes: tableau périodique
- noyaux: modèle en couches
- agrégats: couches et supercouches

Existence de nombres magiques correspondant au remplissage complet des niveaux quantiques des fermions indépendants par ceux-ci jusqu'à l'énergie de Fermi.

COUCHES DANS LES ATOMES



Energies

COUCHES DANS LES AGREGATS

Nombres magiques: $N = 2.8 \pm 18.20$

 $N = 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, \dots$



Modèle du jellium avec potentiel effectif auto-consistant

AGREGATS ALCALINS

Nombres magiques: N = 2, 8, 20, 40, ...



W. A. de Heer, *The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models*, Rev. Mod. Phys. **65** (1993) 611.

AUTRES AGREGATS



W. A. de Heer, *The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models*, Rev. Mod. Phys. **65** (1993) 611.

EFFET DES COUCHES SUR LE POTENTIEL D'IONISATION



W. A. de Heer, *The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple models*, Rev. Mod. Phys. **65** (1993) 611.

PLOTS QUANTIQUES SEMICONDUCTEURS

Particules semiconductrices de quelques nanomètres en solution, illuminées par de la lumière UV et émettant par fluorescence de la lumière visible à une longueur d'onde caractéristique de la taille de la nanoparticule.







PLOTS QUANTIQUES SEMICONDUCTEURS

Image de nanocristaux avec un cœur de CdSe, une couche de ZnS ou CdS et une autre de silice dans une solution aqueuse, tous illuminés par une lampe UV.

Spectres d'émission par fluorescence de nanocristaux semiconducteurs recouverts de surfactants.

Filaments d'actine en rouge dans des fibroblastes de souris (largeur 84 µm).





M. Bruchez Jr., M. Moronne, P. Gin, S. Weiss & A. P. Alivisatos, Science **281** (1998) 2013 W. C. W. Chan & S. Nie, Science **281** (1998) 2016

Prix Nobel de chimie 2023



EFFET DE TAILLE SUR LA FLUORESCENCE

L. E. Brus, J. Chem. Phys. 79 (1983) 5566; 80 (1984) 4403.

ZnS

bande conductrice (électrons e⁻)



B. O. Dabbousi, et al. (1997)

ГОРО

EFFET DE TAILLE SUR LA FLUORESCENCE

L. E. Brus, J. Chem. Phys. 79 (1983) 5566; 80 (1984) 4403.



EFFET DE TAILLE SUR LA FLUORESCENCE

L. E. Brus, J. Chem. Phys. 79 (1983) 5566; 80 (1984) 4403.

